科学研究費助成事業 研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 17,400,000円

研究成果の概要(和文):波長13.5nmの次世代半導体露光用光源(極端紫外光源)や、さらに波長の短い水の窓 光源(波長2.3-4.4nm)に代表されるように、軟X線領域光源の応用は多岐にわたる。低コストで手軽に利用でき る軟X線光源として、プラズマは有力な候補である。プラズマによる軟X線の放射は、多価電離イオンの電子遷移 によるものであり、所望の光源性能を得るためには、プラズマのイオン価数や密度・温度を計測・制御すること が必須である。本課題ではレーザー散乱法を用いて、それらパラメータの非接触かつ局所計測法の開発を行っ た。

研究成果の概要(英文): Soft X-ray light source have been used for various applications, such as extreme-ultraviolet(EUV) light sources (wavelength 13.5 nm) for next-generation semiconductor lithography system and water-window light sources (wavelength 2.3-4.4 nm), Laser-produced plasma is an attractive candidate for the Sof X-ray light source, because the plasma can be easily produced by table-top laser system. In order to optimize the plasma as the soft-X-ray light sources, to measure and control fundamental plasma parameters, such as averaged ionic charge state (Z), electron density (ne), and electron temperature (Te) are prerequisite. We have developed a new measurement system to obtain these plasma parameters. In our system, both ion and electron feature spectra of collective Thomson scattering have been observed simultaneously. From these spectra, it is possible to determine Z, ne, and Te.

研究分野: プラズマ工学

キーワード: 軟X線光源用プラズマ トムソン散乱 レーザー生成プラズマ 電子密度 電子温度 平均イオン価数

1.研究開始当初の背景

多価電離プラズマを軟X線の光源に利用 する研究は、多方面で精力的に進められてい る。代表例として、波長 13.5 nm における極 端紫外リソグラフィ(Extreme-ultraviolet lithography, EUVL)がある。EUVLでは、比 較的安価で高い光量を得られることから、光 源としてレーザー生成プラズマ (laser-produced plasma, LPP)が使用されてお り、その実用化は目前まで迫っている。一方 で、LPPを光源とする研究はさらに短い波長 へと発展している。

2.研究の目的

波長 2.3-4.4 nm 帯の水の窓領域における生 体その場観測用光源や、EUVL の次の世代の リソグラフィ光 (beyond-EUV, B-EUV、波長 6 nm 台) である。しかし、EUVL の例からも 分かる通り、その最適設計は容易ではない。 プラズマ発光の波長ピークはイオン価数(Z) に直接的に決定されるため、電子密度(n_e) や電子温度(T_e)を制御し、最適なZを達成 する必要がある。これらのパラメータを同時 観測できれば、光源設計の大きな指針となり うる。本課題に先んじて、我々は協同的トム ソン散乱のイオン項計測を実現し、EUV 光源 用プラズマの診断手法を確立した[1,2]。しか し、水の窓領域や B-EUV 用の光源プラズマ は EUV に比べ、より多価電離しており、イ オン項のみの計測では不十分になる。そこで、 イオン項に加え、電子項を同時に計測し、不 足情報を補完しあうことでの測定達成を目 指している。

3.研究の方法

レーザートムソン散乱 (laser Thomson scattering, LTS)法は、プラズマ内に電磁場を 入射した際の、自由電子からの散乱光を分光、 解析することで、局所的なプラズマの温度、 n_e、Zを求めることができる測定法である。 トムソン散乱計測用レーザーに Nd:YAG レー ザーの第2高調波(λ=532 nm)を用いると、 多価電離プラズマから得られるトムソン散 乱スペクトルは散乱パラメータ α が1より大 きくなり、散乱には電子とイオンの集団的効 果が現れ、協同的散乱領域に入る。この領域 は、イオン項がレーザー波長を中心として 0.1 -0.2 nm 程度のスペクトル拡がりを持つのに 対し、電子項のスペクトル拡がりは10nm 程 度まで拡がる。イオン項には n_e、T_e、イオン 温度(T_i) Zの情報が含まれるため、計測さ れた散乱光スペクトルの散乱光強度、形状及 びピーク間隔を求めることで以上のパラメ ータを求めることができる。しかし、Z> 20 の多価電離プラズマでは、散乱スペクトルの 形状によるT_eとZの分離が困難になる。一方、 電子項のスペクトルは、ピーク間隔から n_e、



図 1. 装置概略図



図 2. 同時計測のための分光システム

形状からT。を求めることができる。そのため、 電子項とイオン項を同時計測することで、T_e とZの分離ができるだけでなく、n。のクロス チェックも可能となる。波長域や強度の大き く異なるイオン項・電子項同時計測にあたり、 高分散と低分散を同時に達成できる新たな 分光器を作製した。実験装置の概略図を図 1、 分光器の概要図を図2に示す。数百 pm しか 波長が広がらないイオン項計測部は、迷光対 策として極めて狭帯域のみをカットするノ ッチ部と、十分な波長分解能を達成する高分 散部からなる。一方、電子項はスペクトルの 波長広がりが大きいため、低分散部とノッチ 部からなっている。波長分解の点でイオン項 に比べて計測が容易に見える電子項である が、散乱光強度が小さい欠点がある。プラズ マ生成直後では、プラズマの自発光に埋もれ てその計測が困難になる。そのため、誘導ブ リルアン散乱 (stimulated Brillouin scattering, SBS)システムを用いたピコ秒パルス幅レー ザーを使用することで S/N 比を改善し、安定 した電子項計測を可能とするシステムの開 発を同時進行で行っている。

多価電離プラズマへの適用へ向け、レーザ ー生成空気プラズマを対象とした計測シス テムの評価を行った。空気プラズマは、パラ メータ範囲がよく知られており、ターゲット などの反射物がないため迷光が非常に少な く、診断システムの評価に適している。



図 3. イオン項の計測結果

4.研究成果

Fig.3(a)、Fig.4(a)は、プラズマ生成後 1.5 μ s でのレーザートムソン散乱のイオン項、電子 項のスペクトルイメージ図である。この図で は、横軸は中心波長 λ_0 からの差波長を表し、 縦軸は空間的位置を表す。

Fig.3(b)、Fig.4(b)は、プラズマ生成後 1.5 µs でのイオン項、電子項のフィッティング画像 である。横軸は、中心波長丸。からの波長差を 表し、縦軸は強度を表す。このように、同一 条件のプラズマに対して、イオン項および電 子項スペクトルの明確な空間分布計測を達 成した。

軟X線光源用多価電離プラズマのパラメータ 計測に向けて、レーザー生成空気プラズマに 対して、イオン項・電子項の同時計測を行っ た。新たに作製した分光器を用いて、プラズ マ生成後 1.5 μs の時刻で、両スペクトルの明 確な空間分布を観測した。

プラズマ生成後直後の時刻では、高い電子 密度により、プラズマの自発光の増加、並び に電子項強度の現象が予想される。自発光と トムソン散乱光の強度比の改善は、散乱角度 の変更や、計測時間幅の縮小により期待され るが、そのためのシステム構築を行っていく。



〔引用文献〕

[1]: K. Tomita, Y. Sato, S. Tsukiyama, T. Eguchi, K. Uchino, K. Kouge, H. Tomuro, T. Yanagida, Y. Wada, M. Kunishima, G. Soumagne, T. Kodama, H. Mizoguchi, A. Sunahara, K. Nishihara, "Time-resolved two-dimensional profiles of electron density and temperature of plasmas laser-produced tin for extreme-ultraviolet lithography light sources", Scientific Reports 7 12328(7pages) (2017). [2]: K. Tomita, Y. Sato, K. Nishikawa, K. Uchino, T. Yanagida, H. Tomuro, Y. Wada, M. Kunishima, T. Kodama, H. Mizoguchi, A. Sunahara, "Development of a collective Thomson scattering system for laser-produced tin plasmas for

extreme-ultraviolet light sources", *Appl. Phys. Express* **8**, 126101(4pp) (2015).

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔学会発表〕(計 5件)

 (Invited talk) <u>K. Tomita</u>, Y. Sato, T. Eguchi, S. Tsukiyama, T. Shiraishi, M. Yoneda, K. Uchino, K. Kouge, H. Tomuro, T. Yanagida, Y. Wada, M. Kunishima, T. Kodama, H. Mizoguchi, T. Nakano, K. Murai, Y. Tanaka, K. Suzuki, T. Shinkai: "Collective Thomson scattering diagnostics for industrial plasmas", Joint 13th Asia Pacific Physics Conference and 22nd Australian Institute of Physics Congress (APPC-AIP), Brisbane, Australia, 2016.12

- (Invited talk) <u>K. Tomita</u>, Y. Sato, S. Tsukiyama, T. Eguchi, K. Uchino, K. Kouge, T. Yanagida, H. Tomuro, Y. Wada, M. Kunishima, T. Kodama, H. Mizoguchi: "Correlation of Fundamental Plasma Parameters with EUV Emission Profiles of Laser-produced Sn Plasmas for EUV Lithography Light Sources", International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources (2016 Source Workshop), Amsterdam, The Netherlands, 2016.11
- (Invited talk) <u>K. Tomita</u>, Y. Sato, S. Tsukiyama, R. Fukada, K. Uchino, T. Yanagida, H. Tomuro, K. Kouge, Y. Wada, M. Kunishima, T. Kodama, H. Mizoguchi, "Two-dimensional profiles of electron density and temperature of laser-produced tin microplasmas for extreme-ultraviolet lithography light sources, International Workshop on Microplasmas (IWM2017), Garmisch-Partenkirchen, Germany, 2017.6
- (Invited talk) <u>K. Tomita</u>, Y. Sato, S. Tsukiyama, R. Fukada, K. Uchino, T. Yanagida, H. Tomuro, K. Kouge, Y. Wada, M. Kunishima, T. Kodama, H. Mizoguchi, "Two-dimensional electron density and temperature profiles of EUV light sources with 4.0% CE, International workshop on EUV and Soft X-ray sources (2017 source workshop), Dublin, Ireland, 2017.11
- (Invited talk) <u>K. Tomita</u>, Y. Sato, S. Tsukiyama, R. Fukada, K. Uchino, T. Yanagida, H. Tomuro, K. Kouge, Y. Wada, M. Kunishima, T. Kodama, H. Mizoguchi: "Diagnostics of extreme-ultraviolet (EUV) light source plasmas for next generation semiconductor lithography", International Symposium in 27th Annual Meeting of MRS-J, Yokohama, Japan, 2017.12

6.研究組織

(1)研究代表者
富田健太郎(TOMITA, Kentaro)
九州大学・大学院総合理工学研究院・助教
研究者番号:70452729